

第156回 応用物理学会シリコンテクノロジー分科会研究会

日時：2013年2月15日 13時より

場所：東京大学本郷キャンパス工学部9号館1階大会議室
(東京都文京区弥生2-11-16、千代田線根津駅或いは南北線東大前駅下車)
研究集会終了後、懇親会を開催します。

担当：ナノ・マイクロファブリケーション研究委員会

テーマ：「プラズマプロセスの最前線」

スコープ：今年度、プラズマ応用関連の国際学会であるAVS(米国真空学会)、GEC(電離気体国際会議)、DPS(ドライプロセスシンポジウム)や主要なデバイス関連学会で活躍された研究者を中心に招待し、プロセステクノロジーとデバイステクノロジーの最新動向を有機的に議論する場を提供する。

(以下、敬称略)

■開会の辞 13:00-13:05

■若手研究者 13:05-15:25 (質疑込み 35分)

京大 津田 博隆	Si エッチングにおけるプラズマ・表面相互作用のモデリングと形状進展シミュレーション
京大 松田 朝彦	プラズマからのイオン照射ダメージと光学的評価手法
阪大 伊藤 智子	プラズマエッチングにおけるナノメートル表面層反応機構の解明
名大 宮脇 雄大	ガスデザインに基づいた高選択絶縁膜エッチング実現の検討

(休憩 15:25-15:35)

■特別講演■ 15:35-16:20 (質疑込み 45分)

慶應義塾大 真壁 利明 マイクロセル、大気圧プラズマのシミュレーション

■先端プラズマ応用技術■ 16:20-17:30 (質疑込み 35分)

東工大 野崎 智洋	シリコンインクおよび有機・無機ハイブリッド太陽電池の開発
TEL 守屋 剛	ドライエッチング装置 震災からの復興

(総合討論)

■閉会の辞

会議終了後 懇親会